



(12) CERERE DE BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: a 2009 01037

(22) Data de depozit: 11.12.2009

(41) Data publicării cererii:  
29.07.2011 BOPI nr. 7/2011

(71) Solicitant:  
• UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS"  
DIN GALAȚI, STR. DOMNEASCĂ NR.111,  
GALAȚI, GL, RO

(72) Inventatori:  
• BANU MIHAELA, STR.SATURN NR.10,  
BL.B2, SC.3, AP.28, GALAȚI, GL, RO;  
• BURUIANĂ ALICE NICOLETA,  
STR. SLĂNIC NR.1, BL.4G, AP.36, GALAȚI,  
GL, RO;

• STAN FELICIA, STR. CĂLUGĂRENI  
NR.11, BL. L 1 A, SC.2, PARTER, AP.21,  
GALAȚI, GL, RO;  
• MARINESCU VASILICĂ,  
STR. GEORGE COȘBUC NR.37,  
BLOC C 20, AP.35, GALAȚI, GL, RO;  
• EPUREANU ALEXANDRU,  
STR. ALEXANDRU LĂPUȘNEANU NR.16,  
BL.B6, AP.16, GALAȚI, GL, RO

(54) **METODĂ PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CARACTERISTICILOR  
MECANICE ALE MATERIALELOR METALICE  
POLICRISTALINE NANOSTRUCTURATE PRIN DEFORMARE  
PLASTICĂ SEVERĂ**

(57) Rezumat:

Invenția se referă la o metodă de îmbunătățire a proprietăților mecanice finale ale materialelor policristaline, cum sunt modulul de elasticitate Young sau rezistența la tracțiune, care se nanostructurează prin deformare plastică severă, folosind forfecarea multi-direcțională controlată. Metoda conform invenției constă în modificarea parametrilor procesului de deformare plastică severă, cum sunt traiectoria de deformare și viteza de deformare a materialelor metalice cu mărirea grăunților mai mică de 50 nm, valorile optime ale acestor parametri calculându-se pe baza corelației dintre evoluția gradului de deformare aplicat materialului care se nanostructurează, pe de o parte, și evoluția profilului energetic al canalului de dislocații, calculat ca o energie liberă de tip potențial Gibbs, pe de altă parte, canalul de dislocație asimilându-se cu un lanț de proteină Chymotrypsin Inhibitor 2, care parcurge o succesiune de plieri - deplieri marcate în profilul energetic prin tranziții de stare, preluând de la proteină

profilul energetic ce reprezintă toată evoluția de pliere - depliere, pe intervalul considerat, putându-se determina valorile parametrilor ce se aplică unui proces de deformare plastică severă, astfel încât evoluția dislocațiilor din acel material să fie similară cu evoluția geometrică a proteinei de la starea nativă, pliată, cu energie maximă, la starea denaturată cu energie minimă, depliată, iar în final, la un cumul de traiectorii cunoscute ale canalelor de dislocații, se vor obține structuri ordonate ale atomilor, așa cum se structurează și lanțurile de proteine în stare nativă, pliată.

Revendicări: 3  
Figuri: 5



## - Descrierea inventiei -

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI
Cerere de brevet de invenție
Nr. a 2009 01037
Data depozit 11-12-2009

Inventia se refera la o metoda de imbunatatire a caracteristicilor mecanice finale ale materialelor policristaline care se nanostructureaza prin deformare plastica severa, cum ar fi spre exemplu modulul de forfecare, prin intermediul caruia se evalueaza plasticitatea materialului.

Metoda poate fi aplicata la acele procese de nanostructurare prin deformare plastica severa la care directia dupa care are loc deformarea plastica a materialului poate fi modificata in cursul procesului, cum ar fi spre exemplu metoda de forfecare multidirectionala controlata.

Se cunoaste faptul ca nanostructurarea metalelor are ca efect diminuarea marimii graunților cristalini. Functie de nivelul de diminuare, caracteristicile mecanice ale materialelor metalice se modifica, in sensul cresterii rezistentei la tractiune a materialului sau cresterii plasticitatii acestuia. In prezent, modificarea caracteristicilor mecanice este un rezultat natural al procesului de nanostructurare prin deformare plastica severa, fiind obtinut fara nici un fel de interventie in procesul de nanostructurare, nici in ceea ce priveste caracteristica mecanica ce se modifica prin nanostructurare si nici in ceea ce priveste nivelul acestei modificari.

Privitor la metodele de nanostructurare prin deformare plastica severa, o metoda recent aparuta este aceea bazata pe forfecare multidirectionala controlata, la care cinematica procesului de deformare plastica este controlata numeric si permite schimbarea permanenta a directiei de forfecare.

Unul dintre dezavantajele actualelor metode de nanostructurare prin deformare plastica severa este acela ca nu se tine cont de legatura ce exista intre caracteristicile structurii cristaline a materialului, starea de tensiune la care acesta este supus in timpul procesului de nanostructurare, directia dupa care are loc deformarea plastica, pe de o parte, si, pe de alta parte, valorile finale ale caracteristicile mecanice ale materialului nanostructurat.

Problema tehnica pe care o rezolva inventia consta in furnizarea unei metode de imbunatatire a caracteristicilor mecanice ale materialelor metalice policristaline nanostructurate prin deformare plastica severa, metoda prin care se poate asigura utilizarea mai completa a capacitatii materialului de a-si imbunatati prin nanostructurare anumite proprietati mecanice, cum ar fi de exemplu modulul de elasticitate, modulul de forfecare sau rezistenta la rupere, si anume acele proprietati care corespund nevoilor tehnologice ori functionale, specifice unui anumit caz concret.

Metoda pentru imbunatatirea caracteristicilor mecanice ale materialelor metalice policristaline nanostructurate prin deformare plastica severa, potrivit inventiei, inlatura dezavantajele de mai sus, prin aceea ca, **a)** consta in controlul distributiei dislocatiilor, prin modificarea permanenta a directiei dupa care are loc deformarea plastica severa, precum si prin aceea ca, **b)** controlul distributiei dislocatiilor se bazeaza pe controlul densitatii de dislocatie care, la randul ei, se obtine printr-un anumit patern al deplasarii si intersectiei dislocatiilor, patern care in continuare este controlat prin modificarea dupa program a traiectoriei liniei de forfecare a materialului, program stabilit de operatorul instalatiei de nanostructurare

si de asemenea prin aceea ca, c) printr-un model biomimetic, se determina succesiunea de secvente pe care dislocatiile ar trebui sa o urmeze, astfel incat sa se obtina densitatea de dislocatii necesara, valoarea careia a fost in prealabil determinata prin simulari bazate pe modelare cu dinamica moleculara si identificare cu modele ARMA.

Inventia prezinta urmatoarele avantaje:

- asigura in permanenta folosirea completa a capacitatii materialelor de imbunatatire prin nanostructurare a caracteristicilor lor mecanice;
- se poate aplica la toate instalatiile de nanostructurare unde starea de tensiuni si deformatii la care este supus materialul in timpul nanostructurarii poate fi modificata, atat in ceea ce priveste marimea, cat si directia;
- permite imbunatatirea uneia sau alteia dintre caracteristicile mecanice ale materialului, functie de nevoile tehnologice sau functionale, specifice fiecarui caz concret.

Un exemplu de aplicare a inventiei, in cazul nanostructurarii prin forfecare multidirectionala controlata, se prezinta in continuare, in legatura cu fig. 1...5, unde:

- fig. 1 prezinta schema procedurii de nanostructurare prin forfecare multidirectionala controlata, unde a) este o sectiune longitudinala prin dispozitivul de nanostructurare iar b) este traiectoria pe care o are orice punct material apartinand semifabricatului si care se afla in zona de nanostructurare; 1 - semifabricat supus nanostructurarii, 2, 3 - semimatrite de deformare;

- fig. 2 prezinta algoritmul de aplicare a metodei, unde:  $G_i$  - modulul de forfecare initial al materialului inainte de nanostructurare,  $G_f$  - modulul de forfecare final al materialului dupa nanostructurare,  $\delta_D$  - densitatea de dislocatii  $\mu m^{-2}$ ,  $N$  - functia de forma pentru energia libera,  $F_{1,2}$  - fortele aplicate materialului supus nanostructurarii in procesul de deformare plastica la rece prezentat in figura 1,  $s$  - avansul semifabricatului in procesul prezentat in figura 1 a,  $v$  - viteza de deplasare a semimatritei 3 fata de semimatrita 2; coordonatele traiectoriei de deformare sunt cele corespunzatoare traiectoriei pe care o urmeaza orice punct material apartinand semifabricatului si care se afla in zona de nanostructurare, asa cum acest lucru este exemplificat in figura 1 b.

- fig. 3 prezinta functia de forma a energiei necesare tranzitiei de la o stare la alta;  $A$  - traiectoria dislocatiei la energie de activare minima la un grad de deformare plastica normala;  $N$  - traiectoria dislocatiei la energie de activare mare, corespunzator unui grad de deformare mare (structura ordonata).

Aceste functii de forma se obtin la anumite succesiuni de pliere - depliere ale proteinei CI2. Astfel, prin analogie intre traiectoria urmata de un reziduu apartinand unei proteine si atomii dintr-un plan transversal al unui canal de dislocatie, se alege o functie de forma corespunzatoare acelor secvente de pliere - depliere care prin

cumulare duc la o energie echivalenta cu  $\Delta G_d$ , unde: a) este traiectoria unei dislocatii obtinuta pentru Cu, prin simulare cu dinamica moleculara in urmatoarele conditii: modul de forfecare initial  $G_i = 42$  GPa, coeficientul lui Poisson  $\nu = 0,347$ , vectorul Burger  $b = 0,256$  nm, raza de indentare  $r_i = 50$  nm, modulul de elasticitate longitudinal  $E = 123$  GPa; numarul de atomi folositi in simulare 149, intr-un volum

reprezentativ de  $6.9 \times 6.9 \mu\text{m}$  cu un increment de timp de  $0,5-0,6\text{ns}$  și o tensiune tangentială de forfecare  $\tau_{\text{max}}=10,7\text{GPa}$ , temperatura fiind de  $225^{\circ}\text{C}$  iar b) este traiectoria prin care proteina CI2 se depliază (starea N – nativă este pliata în care energia liberă este maximă, starea D – denaturată în care energia liberă este minimă, și corespunde cu starea de entropie minimă, adică stare amorfă);

- fig. 4 prezintă analogia dintre traiectoria dislocațiilor la nanostructurarea Cu (a) și traiectoria de deformare a proteinei CI2 (inhibitor chimostripsina) la  $225^{\circ}\text{C}$  (b);

- fig. 5 prezintă evoluția energiei libere în funcție de densitatea de dislocații. Când densitatea de dislocații crește, se ajunge la o valoare critică,  $\rho_{\text{crit}}$  care verifică egalitatea dintre energia liberă a dislocațiilor și energia liberă corespunzătoare stării amorfe. Această stare corespunde superplasticității, când deformarea în continuare se bazează pe alunecarea atomilor unii față de ceilalți.

Procedeul de nanostructurare a materialelor policristaline la care se exemplifică aplicarea metodei este acela bazat pe forfecarea multidirecțională controlată a materialului. Schema acestui procedeu este prezentată în figura 1. Bara de material **1** este supusă unei compresiuni axiale prin aplicarea forțelor **F1** și **F2** și unei forfecări transversale, prin deplasarea semimatritei **2** în raport cu semimatrita fixă **3**. Deplasarea semimatritei **2** are loc după traiectoria **T** și este controlată cu ajutorul unui sistem de comandă numerică. Forma traiectoriei **T** poate fi programată. De exemplu, în cazul din figura 1, traiectoria (paternul de deformare) programată este **O-t1-t2-t3-t4-t5...O**. În plus, prin deplasarea **s** a semifabricatului, în direcția axială, zona de deformare este deplasată de-a lungul axei semifabricatului, iar paternul de deformare se schimbă sau nu periodic. În acest fel, în două secțiuni transversale vecine, paternul de deformare realizat poate fi același sau diferit. Distanța dintre două secțiuni vecine reprezintă pasul de nanostructurare și poate fi reglată corespunzător

Metoda constă în aplicarea unei succesiuni de pași, astfel stabiliți încât caracteristicile mecanice finale ale materialului nanostructurat să fie superioare celor ale materialului supus nanostructurării.

Pasul 1 constă în determinarea mărimii parametrului ce corespunde proprietăților mecanice finale ale materialului nanostructurat.

Pasul 2 constă în exprimarea variației de energie ( $\Delta G_d$ ) în funcție de densitatea de dislocații ( $\rho_d$ ) într-un cristal cu volum molar cunoscut ( $M_v$ ), vectorul Burger ( $b$ ) și modulul de forfecare ( $G_F$ ), [Tromans and Meech, Miner. Eng. 12 (6), 1999] folosind legătura dintre aceste mărimi în următoarea formă:

$$\Delta G_d = \rho_d M_v \frac{b^2 G_F}{4\pi} \ln \left( \frac{2\rho_d^{-1/2}}{b} \right) \quad (1)$$

În starea amorfă, energia este exprimată prin relația (2):

$$\Delta G_{am} = \left( \frac{\Delta H_f}{T_m} \right) (T_m - T) \quad (2)$$

unde  $\Delta G_{am}$  reprezinta energia necesara transformarii de la starea cristalina la starea amorfa,  $\Delta H_f$  este caldura de topire necesara trecerii de la stare cristalina la stare amorfa,  $T_m$  este temperatura lichidus iar  $T$  este temperatura curenta.

Starea de nanostructurare sub 20 nm este similara starii amorfe. Din acest motiv, energia libera poate fi exprimata prin

$$\Delta G_d = \Delta G_{am} \quad (3)$$

Inlocuind (1) si (2) in (3) se calculeaza densitatea de dislocatie corespunzatoare trecerii de la stare cristalina la stare amorfa, corespunzatoare unei nanostructurari cu graunti de 20 nm.

Pasul 3 consta in aceea ca, pentru a obtine, in microstructura, valoarea densitatii de dislocatie calculata, se determina coordonatele paternului de deformare **O-t1-t2-t3-t4-t5...O**, ce va fi utilizat in nanostructurare.

Pentru a ajunge la nivelul energetic necesar, se considera o anumita evolutie a acestei marimi, ale carei functii de forma se asimileaza cu functia de forma a energiei de activare a plierii-deplierii proteinelor. Aceasta functie de forma, corespunzatoare plierii-deplierii proteinelor, este prezentata in figura 3.

La anumite succesiuni de pliere – depliere ale proteinei **CI2**, aceste functii de forma sunt specifice. Prin analogie intre traiectoria urmata de un reziduu apartinand unei proteine si atomii dintr-un plan transversal al unui canal de dislocatie, se alege o functie de forma corespunzatoare acelor secvente de pliere – depliere care prin cumulare duc la o energie echivalenta cu cea necesara.

Pasul 4 consta in stabilirea succesiunii paternurilor pe care canalele de dislocatie din material trebuie sa le urmeze.

Pasul 5 consta in aceea ca, prin simulare cu dinamica moleculara, se genereaza o baza de date, cu diferite traiectorii ale canalelor de dislocatie, corespunzatoare diferitelor conditii de process (diferite traiectorii **O-t1-t2-t3-t4-t5...O**).

Folosind un model ARMA se identifica acea traiectorie **O-t1-t2-t3-t4-t5...O** care corespunde secventelor de pliere-depliere ale canalelor de dislocatie ce conduc la obtinerea densitatii de dislocatie calculate si implicit la valoarea caracteristicii mecanice tinta, de exemplu la valoarea modulului de forfecare tinta.

## - Revendicari -

1. Metoda pentru imbunatatirea caracteristicilor mecanice ale materialelor metalice policristaline nanostructurate prin deformare plastica severa, caracterizata prin aceea ca, in scopul de a obtine imbunatatirea unei anumite caracteristici mecanice a materialului nanostructurat, consta in controlul distributiei dislocatiilor, prin modificarea permanenta a directiei dupa care are loc deformarea plastica severa.

2. Metoda pentru imbunatatirea caracteristicilor mecanice ale materialelor metalice policristaline nanostructurate prin deformare plastica severa, potrivit revendicarii 1, caracterizata prin aceea ca pentru a controla distributia dislocatiilor se controleaza densitatea de dislocatie care, la randul ei, se obtine printr-un anumit patern al deplasarii si intersectiei dislocatiilor, patern care la randul lui este controlat prin modificarea dupa program a traiectoriei liniei de forfecare a materialului, program stabilit de operatorul instalatiei de nanostructurare.

3. Metoda pentru imbunatatirea caracteristicilor mecanice ale materialelor metalice policristaline nanostructurate prin deformare plastica severa, potrivit revendicarii 1, caracterizata prin aceea ca, printr-un model biomimetic, se determina succesiunea de secvente pe care dislocatiile ar trebui sa o urmeze, astfel incat sa se obtina densitatea de dislocatii necesara, valoarea careia a fost in prealabil determinata prin simulari bazate pe modelare cu dinamica moleculara si identificare cu modele ARMA.

- Figuri -

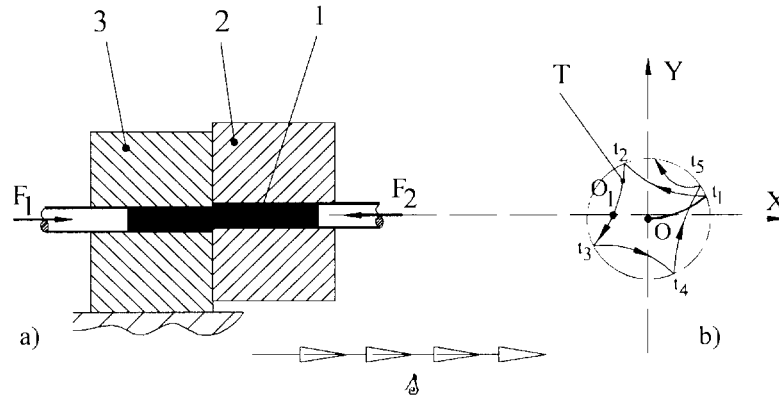


Figura 1

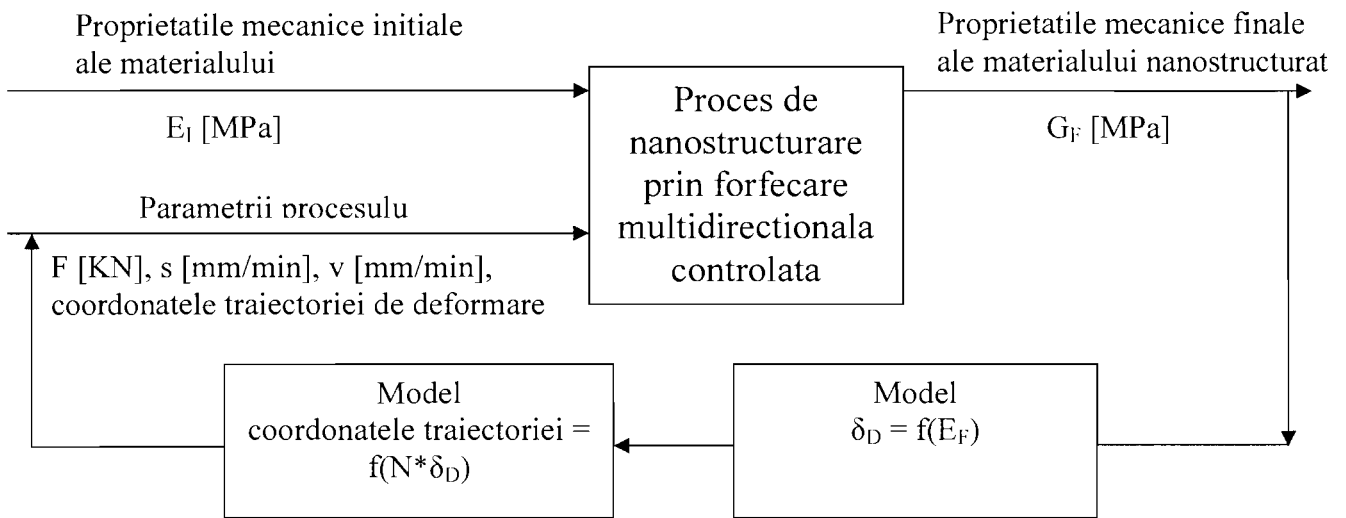


Figura 2

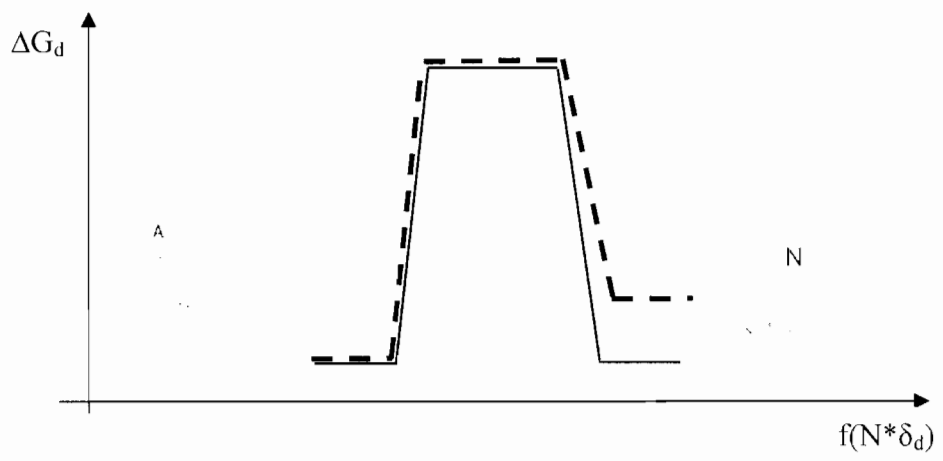
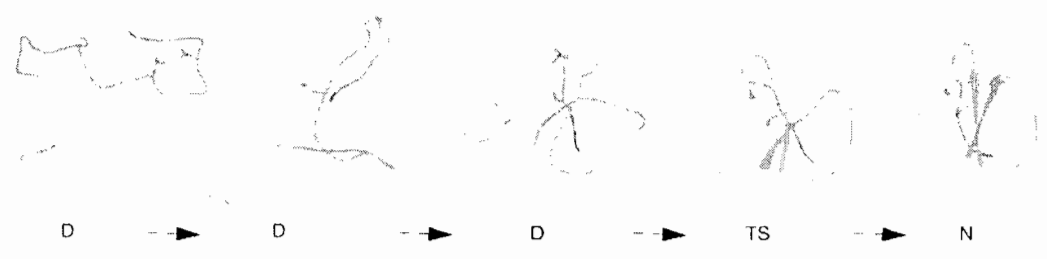
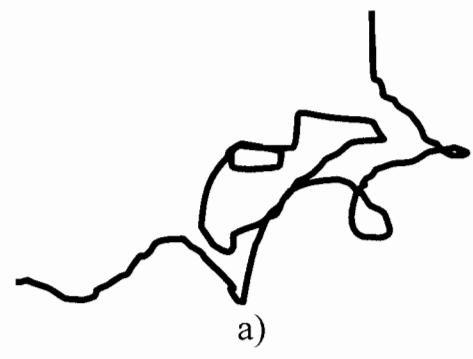


Figura 3



b)  
Figura 4



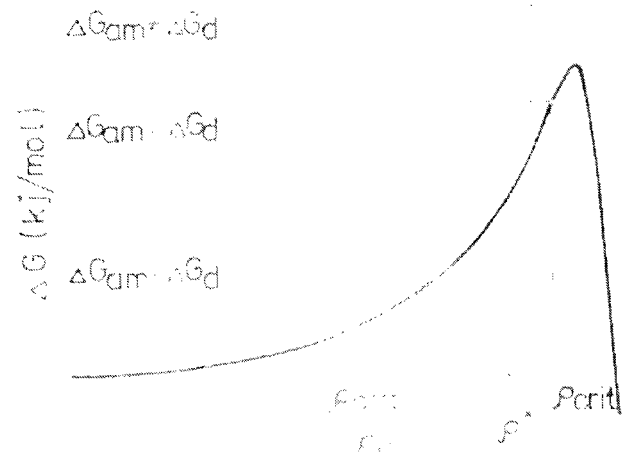


Figura 5